

R/W	R/W	
位定义		
[7:0]	E2PD1	16 位模式时用于存储 16 位数据的高 8 位 32 位模式时用于存储低 16 位数据的高 8 位

FLASH 数据寄存器- E2PD2

E2PD2 – FLASH 数据寄存器 2		
E2PD2: 0x57		默认值: 0x00
Bits	E2PD2[7:0]	
R/W	R/W	
位定义		
[7:0]	E2PD2	32 位模式时用于存储高 16 位数据的低 8 位

FLASH 数据寄存器- E2PD3

E2PD3 – FLASH 数据寄存器 3		
E2PD3: 0x5C		默认值: 0x00
Bits	E2PD3[7:0]	
R/W	R/W	
位定义		
[7:0]	E2PD3	32 位模式时用于存储高 16 位数据的高 8 位

FLASH 模式控制寄存器- ECCR

ECCR – FLASH/E2PROM 配置寄存器								
ECCR: 0x36 (0x56)					默认值: 0x0C			
bits	WEN	EEN	ERN	SWM	CP1	CP0	ECS1	ECS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	1	1	0	0
位定义								
[7]	WEN	ECCR 写使能控制 在修改 ECCR 前, 必须先将 WEN 写 1, 然后在 6 个系统周期内, 更新 ECCR 寄存器的内容						
[6]	EEN	E2PROM 使能, 仅对 LGT8F328P 有效 1: 使能 E2PROM 模拟, 将会从 32KFLASH 中保留部分空间 0: 禁用 E2PROM 模拟, 32KFLASH 全部用于程序空间						
[5]	ERN	写 1 将复位 E2PCTL 控制器						
[4]	SWM	连续写模式, 适用于模拟 E2PROM 控制器操作						
[3]	CP1	页交换 CP1 区域使能控制						
[2]	CP0	页交换 CP0 区域使能控制						
[1:0]	ECS[1:0]	E2PROM 空间配置 00: 1KB E2PROM, 30KB 程序 FLASH 01: 2KB E2PROM, 28KB 程序 FLASH						